

28. 9. 2004

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

REC'D	11 NOV 2004
WIPO	PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日 2003年10月 1日
Date of Application:

出願番号 特願2003-343189
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP2003-343189]

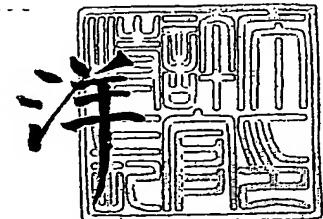
出願人 東邦チタニウム株式会社
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年10月29日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願
【整理番号】 P1561510
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 C01G 23/07
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎 3-3-5 東邦チタニウム株式会社内
 【氏名】 堀 英樹
【特許出願人】
 【識別番号】 390007227
 【氏名又は名称】 東邦チタニウム株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100098682
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 赤塚 賢次
 【電話番号】 03-3251-5108
【選任した代理人】
 【識別番号】 100071663
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 福田 保夫
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 047692
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 9606127
 【包括委任状番号】 9604804

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

ルチル化率が80%以上であって、BET比表面積が $30\text{ m}^2/\text{g}$ 以上である酸化チタン粉末。

【請求項2】

前記ルチル化率が、85%以上である請求項1に記載の酸化チタン粉末。

【請求項3】

前記酸化チタン粉末が、四塩化チタンの気相反応で得られる請求項1記載の酸化チタン粉末。

【請求項4】

前記酸化チタン粉末が、四塩化チタン、酸素、水素及び水蒸気を気相状態下で反応して得られる請求項1に記載の酸化チタン粉末。

【請求項5】

前記酸化チタン粉末が、四塩化チタン、酸素、水素及び水蒸気を予め加熱した後、気相状態下で反応して得られる請求項1に記載の酸化チタン粉末。

【書類名】明細書

【発明の名称】酸化チタン粉末

【技術分野】

【0001】

本発明は比表面積が大きくかつルチル型の酸化チタン粉末に関し、具体的には、電子材料、紫外線遮蔽材料、光触媒材料、ディスプレイの反射防止膜、プラズマディスプレイなどの基盤用隔壁に用いるガラス材のフィラー材、または各種触媒の担体などに適した屈折率の高い酸化チタン粉末に関する。

【背景技術】

【0002】

酸化チタン粉末は、白色顔料として古くから利用されており、近年は化粧品などの紫外線遮蔽材料、光触媒、コンデンサ、サーミスターの構成材料あるいはまたチタン酸バリウムの原料等電子材料に用いられる焼結材料に広く利用されている。また、酸化チタンは可視光付近の波長領域において大きな屈折率を示すため、可視光領域では殆ど光吸収は起こらない。このことから最近化粧料、医薬あるいは塗料等の紫外線遮蔽が要求されるような材料や、液晶ディスプレイ表示部やプラスティックレンズなどの反射防止膜として利用されている。反射防止膜は通常フッ素樹脂、シリコーン系樹脂などの低屈折率の樹脂などで形成される層と、高屈折率層を交互に重ねたものであり、酸化チタンはこの反射防止膜の高屈折率層の材料として用いられている。さらに最近需要の増えているプラズマディスプレイにおいては、その輝度を向上させるため、基盤用隔壁に用いられるガラス材に酸化チタンを被覆して反射率の改善を図ったり、ガラス材にルチル型酸化チタン粉末を配合して屈折率の改善を図ったりしている。

【0003】

なお、ルチル型酸化チタンは、アナターゼ型酸化チタンに比べ、紫外線遮蔽効果や高屈折率などの光学的特性や高誘電特性などの電気特性において優れた性能を発揮することが知られている。

【0004】

酸化チタンの膜を形成するには、従来様々な方法が検討されている。例えば、基板表面に酸化チタンの薄膜を形成させる方法としては、蒸着法、CVD法、スパッタ法などのドライ法、ゾルゲル法、メッキ法、電解重合法などのウェット法が知られている。しかしながらこれらの方針においてルチル型酸化チタン膜を形成するためには、酸化チタン膜を形成した後600℃以上に加熱処理する必要があり、このため用いられる基材がガラス、セラミックスあるいは金属などの無機材料に限られ、その用途が限定されていた。そのためルチル型などの結晶性を持つ酸化チタン粉末をペーストなどの分散液とし、これを基材に塗布して膜を形成することも検討されている。しかしこのような酸化チタン粉末の塗布による方法において、膜の透明性を確保するために粒径をより小さくする必要がある。しかしながら従来の気相法や液相法を用いてより粒径の小さい酸化チタン粉末を製造しようとした場合、得られる酸化チタンの結晶型はルチル型にはならず、アモルファスあるいはアナターゼ型を相当量含むものであった。ルチル型に変換するためには更にこれらの酸化チタンを加熱処理することが必要であり、この加熱処理によって粒子の凝集が生じ、結果として微粒子を維持したままルチル型の酸化チタン粉末を得ることは困難であった。

【0005】

微粒子のルチル型酸化チタンを得る方法としては、特開平7-291629号公報に、超微粒子状アモルファス酸化チタンを、無機酸水溶液中で熟成させることにより超微粒子状ルチル型酸化チタンに変換する方法が開示されている。具体的には、有機チタン化合物や四塩化チタンから生成したアモルファス酸化チタンを塩酸水溶液や硫酸水溶液中で72~2400時間熟成させた後、洗浄し乾燥させてルチル型酸化チタン微粒子を得るものである。

【特許文献1】特開平7-291629号公報（特許請求の範囲、実施例）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

特開平7-291629号公報記載の方法によれば、得られた酸化チタン微粒子中にはルチル型結晶は含まれるもの、全体のルチル化率は必ずしも高くなく、より一層の改善が望まれていた。また、このような方法では、製造に長時間を要し、また工程も煩雑であり生産性が低く、実際に工業的には採用し難いという問題がある。

【0007】

また、比表面積が比較的大きい微粒子の酸化チタン粉末は従来から知られているものの、これらの酸化チタン粉末はルチル型とアナターゼ型の混合物であって、比表面積が $30\text{ m}^2/\text{g}$ 以上の場合にはルチル含有率（またはルチル化率）は約70%以下であった。このように通常酸化チタン粉末はルチルとアナターゼの混合体であるため、粒度分布が比較的広いものであった。

一方、積層セラミックコンデンサの誘電体材料に用いられるチタン酸バリウムなどの原料に酸化チタン粉末が用いられる場合、誘電体粉末の粒径および粒度分布は、使用する酸化チタンの粒度また粒度分布に依存することが知られている。近年の小型化、高容量化のため、積層セラミックコンデンサの積層数は年々増加し、誘電体層および電極層は薄層化している。したがって、用いられる酸化チタン粉末は、より粒径が小さくかつ粒度分布の狭い粉末が要求されている。また、粉末の溶媒に対する分散性も重要であり、この点からも粒度分布の狭い粉末が要求されている。

【0008】

従って、本発明の目的は、より粒径が小さくかつ粒度分布が狭く、高比表面積であり、かつルチル化率の高い酸化チタン粉末を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明者は、上記従来技術に残された課題を解決すべく、鋭意研究を重ねた結果、より粒径が小さくかつ粒度分布が狭く、高比表面積であり、かつルチル化率の高い酸化チタン粉末を見出し、本発明を完成するに至った。

【0010】

すなわち、本発明の酸化チタン粉末は、ルチル化率が80%以上であって、BET比表面積が $30\text{ m}^2/\text{g}$ 以上である。

【発明の効果】

【0011】

本発明の酸化チタン粉末は、従来のものとは異なり、ルチル化率が高いにも拘わらずBET比表面積が大きく、チタン酸バリウムなどの電子材料、紫外線遮蔽材料、光触媒材料、反射防止膜や高反射率が要求されるプラズマディスプレイなどのガラス基材へのコート材やフィラー材として有効である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0012】

本発明の酸化チタン粉末において、ルチル化率は80%以上、好ましくは85%以上、より好ましくは90%以上である。ルチル化率がこのような高い範囲であれば、例えば紫外線遮蔽効果や高屈折率などの光学的特性や高誘電特性などの電気特性において優れた性能を發揮する。

【0013】

ここで、ルチル化率の測定方法は、ASTM D3720-84の方法に従いX線回折測定を行い、ルチル型結晶酸化チタンの最強回折線（面指数110）のピーク面積（I_r）と、アナターゼ型結晶酸化チタンの最強回折線（面指数101）のピーク面積（I_a）を求め、次式により算出して求められる。

【0014】

ルチル化率（重量%） = $100 - 100 / (1 + 1.2 \times I_r / I_a)$
式中、ピーク面積（I_r）及びピーク面積（I_a）は、X線回折スペクトルの該当回折線

におけるベースラインから突出した部分の面積をいい、その算出方法は公知の方法で行え
ばよく、例えば、コンピュータ計算、近似三角形化などの手法により求められる。

【0015】

また本発明の酸化チタン粉末において、BET比表面積は $30\text{ m}^2/\text{g}$ 以上、好ましく
は $33\text{ m}^2/\text{g}$ 以上、より好ましくは $35\text{ m}^2/\text{g}$ 以上である。BET比表面積が $30\text{ m}^2/\text{g}$ 以上であれば、酸化チタン粉末の粒径が小さいものが得られる。

【0016】

また当該酸化チタン粉末において、平均粒径は特に制限されないが、SEM写真での画
像解析による平均粒径で 100 nm 以下、好ましくは $5\sim70\text{ nm}$ である。酸化チタン粉
末の粒径がこのように小さければ、例えば積層セラミックコンデンサの積層数が増加し、
誘電体層および電極層が薄層化しても対応できる。

【0017】

さらに、本発明の酸化チタン粉末は不純物のきわめて少ない高純度であることが望まし
く、酸化チタン粉末中に含まれるFe、Al、SiおよびNaが各々 100 ppm 未満であ
りかつC1が 1000 ppm 未満である。望ましくはFe、Al、SiおよびNaが各々 20 ppm 未満であ
り、C1が 500 ppm 未満、さらに望ましくは 50 ppm 未満である。

【0018】

以上のように本発明の酸化チタン粉末は、比表面積が大きく微粒子であるにもかかわら
ずルチル化率は非常に高く、さらに高純度であるので、チタン酸バリウムなどの電子材料
用に用いた場合、誘電特性などの電気特性に優れるという利点を有する。

【0019】

本発明の酸化チタン粉末を製造する方法としては、特に制限されないが、例えば、四塩
化チタンを気相中で酸素と接触させ酸化させる気相酸化法、燃焼して水を生成する水素ガ
ス等の可燃性ガスと酸素を燃焼バーナーに供給し火炎を形成し、この中に四塩化チタンを
導入する火炎加水分解法などの気相法、および四塩化チタン、アルコキシチタンまたは硫酸
チタニルなどを液相状態下で反応させて酸化チタンを得る液相法が挙げられる。これら
の製法のなかでも、特に四塩化チタンを気相状態下で加水分解あるいは酸化反応させる氣
相法が本発明の高いルチル化率かつ高い比表面積を有する酸化チタン粉末を効率よく製造
できる面で有利である。また、気相法は四塩化チタンを水素、酸素あるいは水蒸気と接
触させ反応させるので、液相法で得られる酸化チタンのような不純物元素が混入または残留す
ることがない。

【0020】

以下、本発明の酸化チタン粉末を気相法において製造する方法について詳しく説明する
。

【0021】

当該製造方法は、四塩化チタンを気相中で加水分解あるいは酸化させる方法であって、
具体的には四塩化チタン蒸気を、水素ガス、酸素ガスおよび水蒸気を気相状態下で接
触させ反応させる。このとき、四塩化チタンガスの反応部への供給量に対し、水蒸気の供給量
を、四塩化チタンをすべて酸化する化学当量以上とすることを望ましい。水蒸気の供給量
が、四塩化チタンをすべて酸化する化学当量未満であると、酸化チタンの生成反応
が均一に行われないため、生成した酸化チタンの結晶制御ができず、高比表面積でルチル
化率の高い酸化チタン粉末や、高比表面積でアナーゼ型の酸化チタン粉末を得ることは
難しい。

ここで、四塩化チタンをすべて酸化する化学当量とは、四塩化チタンを水蒸気のみで反
応させる場合の水蒸気の化学当量を意味し、つまり四塩化チタン1モルに対して水蒸気(水)
を2モルである。本発明の方法において、水蒸気は四塩化チタンに対して過剰、具体
的には供給ガスを標準状態としたときガスの容量で四塩化チタンガスの10倍以上、好
ましくは100倍以上の水蒸気を供給し反応させる。また、酸素の供給量についても、四塩
化チタンをすべて酸化する化学当量以上(四塩化チタン1モルに対して酸素1モル)が好
ましく、具体的には供給ガスを標準状態としたときガスの容量で四塩化チタンガスの10

倍以上の酸素を供給し反応させる。

【0022】

上記各成分の反応部への供給量比であるが、各供給ガスが標準状態としたとき四塩化チタン11(ガス)に対する水素ガス、酸素ガスおよび水蒸気の供給量は表1のとおりである。

【0023】

【表1】

	通常の範囲	好ましい範囲	より好ましい範囲
水素ガス(1)	10~500	20~200	30~100
酸素ガス(1)	10~500	20~200	30~100
水蒸気(1)	100~2000	300~1500	500~1000

上記各原料ガスの供給量は、反応スケールあるいは各ガスを供給するノズル径等により異なるので適宜設定するが、反応部での各ガス、特に四塩化チタンガスの供給速度は乱流域になるように設定することが望ましい。また、供給する上記の各成分をアルゴンや窒素のごとき不活性ガスで希釈し反応部に供給し反応させることもできる。

【0024】

また、上記の四塩化チタンガス、酸素ガス、水素ガス及び水蒸気を反応部に供給する際に、予め加熱して供給して反応させることが望ましく、具体的には700~1000℃、好ましくは750~950℃に加熱する。

【0025】

次いで反応させ酸化チタン粉末を生成させるが、このような酸化チタン粉末を気相反応で形成するためには、酸化チタンが生成する温度以上であり、好ましくは酸化チタンの結晶構造がルチル型に転移する温度より高い温度で反応を行う必要がある。具体的には、900℃以下、好ましくは400~900℃、特に好ましくは450~850℃である。

【0026】

上記のように各成分を反応させ酸化チタン粉末を生成させた後、生成粒子の凝集を防ぐために、少なくとも酸化チタン粒子が焼成する温度以下、具体的には300℃未満まで可及的速やかに冷却を行う。

【0027】

上記のように得られた酸化チタン粉末は、その後粉末に含まれる塩化水素などの塩素分を加熱処理などにより除去し、必要に応じて分級あるいは篩分を行う。

【0028】

以下本発明の酸化チタン粉末を製造する具体的なプロセスの一例を示す。先ず、液状の四塩化チタンを予め800~900℃に加熱し、気化させ、必要に応じて窒素ガスで希釈し反応炉に導入する。四塩化チタンの導入と同時に、予め800~900℃加熱した酸素ガス、水素ガスおよび水蒸気を必要に応じて窒素ガスで希釈して反応炉に導入し、酸化反応を行うが反応温度は通常700~900℃、好ましくは750~900℃である。本発明の酸化チタン粉末を得るためににはこのように比較的低温で酸化反応を行うことが望ましい。生成した酸化チタン粉末を冷却部に導入し、空気などの冷却ガスを酸化チタン粉末に接触させ、酸化チタン粉末を300℃以下に冷却する。その後生成した酸化チタン粉末を捕集し、酸化チタン粉末中に残留する塩素分を、真空加熱、空気あるいは窒素ガス雰囲気中での加熱あるいはスチーム処理等の加熱処理あるいはアルコールとの接触処理により除去し、本発明の酸化チタン粉末を得ることができる。

【0029】

気相法による酸化チタン粉末の製造において、上記のような条件で製造することによつて、酸化チタン粉末を無機酸水溶液中で熟成するなどのアナターゼ型酸化チタンをルチル化する工程を別途行わなくとも、本発明の高いルチル化率で高い比表面積を有する酸化チタン粉末を効率よく製造することができる。

【0030】

本発明の酸化チタン粉末は、チタン酸バリウムなどの電子材料、紫外線遮蔽材料、反射防止膜や高反射率が要求されるプラズマディスプレイなどのガラス基材へのコート材やフィラー材として有効である。

【0031】

次に、実施例を挙げて本発明を更に具体的に説明するが、これは単に例示であって本発明を制限するものではない。

【実施例1】

【0032】

四塩化チタンを気相中で酸素ガス、水素ガスおよび水蒸気と接触させ酸化させる気相法により酸化チタン粉末を調製した。まず、多重管バーナーを上部に具備した内径400mmの気相反応管において、多重管バーナーに、800℃に予熱し気化させた四塩化チタンガスを窒素ガスで希釈して供給し、一方別の供給ノズルより800℃に予熱した水素ガス、酸素ガスおよび水蒸気を供給し、気相反応管内で800℃にて酸化反応させ、酸化チタン粉末を生成させた。このとき四塩化チタンは標準状態として500ml/分、酸素ガスは201/分、水素ガスは201/分、水蒸気は3701/分でそれぞれ供給した。その後、気相反応管の下部に位置する冷却部に室温の乾燥空気を800l/分で供給し、生成した酸化チタン粉末を冷却した。その後、得られた酸化チタン粉末を大気中で350℃～400℃で10時間加熱処理した。このようにして得られた酸化チタン粉末について平均粒径、ルチル化率、比表面積、不純物の含量および粒度分布を測定し、その結果を表2に示した。なお、酸化チタン粉末の平均粒径、ルチル化率、比表面積、不純物の含量および粒度分布は以下の方法により測定した。

(平均粒径)

電子顕微鏡(SEM)により粉末を観察し、インターフェプト法により測定した。なお、解析数は200個である。

(ルチル化率)

ASTM D 3720-84に従いX線回折パターンにおける、ルチル型結晶酸化チタンの最強干渉線(面指数110)のピーク面積(I_r)と、酸化チタン粉末の最強干渉線(面指数101)のピーク面積(I_a)を求め前述の算出式より求めた。なお、X線回折測定条件は下記の通りである。

【0033】

(X線回折測定条件)

回折装置 R A D - 1 C (株式会社リガク製)

X線管球 Cu

管電圧・管電流 40kV, 30mA

スリット DS-SS: 1度, RS: 0.15mm

モノクロメータ グラファイト

測定間隔 0.002度

計数方法 定時計数法

【0034】

(比表面積)

BET法により測定した。

(不純物の定量)

酸化チタン中のFe, Al, SiおよびNa成分については原子吸光法により測定した。
酸化チタン中のC1成分については吸光光度法により測定した。

(粒度分布)

レーザー光散乱回折法粒度測定機(LA-700:堀場製作所)を用い、適量の酸化チタン粉末を純水に懸濁させてから超音波をかけて3分間分散させ、粒度を測定し、体積統

計値の粒度分布を求めた。なお、粒度分布は、D90（積算粒度で90%の粒径（ μm ））、D50（積算粒度で50%の粒径（ μm ））、D10（積算粒度で10%の粒径（ μm ））を求める、粒度分布（SPAN）を下記式で算出した。

$$\text{SPAN} = (\text{D90} - \text{D10}) / \text{D50}$$

【実施例2】

【0035】

四塩化チタンガス、水素ガス、酸素ガスおよび水蒸気予熱温度を850℃にした以外は実施例1と同様に酸化チタン粉末を製造した。得られた酸化チタン粒子の粒径、ルチル化率、比表面積、不純物の含量及び粒度分布を表2に示した。

【実施例3】

【0036】

四塩化チタンガス、水素ガス、酸素ガスおよび水蒸気予熱温度を900℃にした以外は実施例1と同様に酸化チタン粉末を製造した。得られた酸化チタン粒子の粒径、ルチル化率、比表面積、不純物の含量及び粒度分布を表2に示した。

【実施例4】

【0037】

水素ガスおよび酸素ガスの供給量をそれぞれ401／分にした以外は実施例1と同様に酸化チタン粉末を製造した。得られた酸化チタン粒子の粒径、ルチル化率、比表面積、不純物の含量及び粒度分布を表2に示した。

比較例1

【0038】

まず、多重管バーナーを上部に具備した内径400mmの気相反応管において、多重管バーナーに、1100℃に予熱し気化させた四塩化チタンガスを窒素ガスで希釈して供給し、一方別の供給ノズルより1000℃に予熱した酸素ガスと水蒸気の混合ガスを供給し、気相反応管内で1000℃にて酸化反応させ、酸化チタン粉末を生成させた。このとき四塩化チタンは標準状態として500ml／分、酸素ガスは340ml／分、水蒸気は850ml／分でそれぞれ供給した。その後、気相反応管の下部に位置する冷却部に室温の乾燥空気を800l／分で供給し、生成した酸化チタン粉末を冷却した。このようにして得られた酸化チタン粉末について平均粒径、ルチル化率、比表面積、不純物の含量及び粒度分布を測定し、その結果を表2に示した。

比較例2

【0039】

まず、多重管バーナーを上部に具備した内径400mmの気相反応管において、多重管バーナーに、800℃に予熱し気化させた四塩化チタン及び水素ガスの混合ガスを供給し、一方別の供給ノズルより800℃に予熱した酸素ガスを供給し、気相反応管内で約100℃にて酸化反応させ、酸化チタン粉末を生成させた。このとき四塩化チタンは601/分、水素ガスは401/分、酸素ガスは3801/分でそれぞれ供給した。その後、気相反応管の底部から空気を4001/分で挿入し、生成した酸化チタン粉末を冷却した。その後、得られた酸化チタン粉末を大気中で350℃～400℃で10時間加熱処理した。このようにして得られた酸化チタン粉末について粒径、ルチル化率、比表面積、不純物の含量および粒度分布を測定し、その結果を表2に示した。

比較例3

【0040】

まず、多重管バーナーを上部に具備した内径400mmの気相反応管において、多重管バーナーに、約800℃に予熱し気化させた四塩化チタンガスを供給し、一方別の供給ノズルより800℃に予熱した酸素ガス及び水蒸気を供給し、気相反応管内で約1000℃にて酸化反応させ、酸化チタン粉末を生成させた。このとき四塩化チタンは2001/分、酸素ガスは3801/分、水蒸気は1701/分でそれぞれ供給した。その後、気相反応管の底部から空気を1001/分で挿入し、生成した酸化チタン粉末を冷却した。その後、得られた酸化チタン粉末を大気中で350℃～400℃で10時間加熱処理した。このようにして

て得られた酸化チタン粉末について粒径、ルチル化率、比表面積、不純物の含量および粒度分布を測定し、その結果を表2に示した。

【0041】

【表2】

	実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	比較例 1	比較例 2	比較例 3
平均粒径(nm)	38	48	52	50	80	132	163
ルチル化率(%)	90.0	91.7	89.5	92.2	91.5	85.0	87.5
比表面積(m ² /g)	43.0	35.0	34.0	34.5	22	12.5	10.3
不純物の含量(ppm)							
Fe	10	10	10	10	10	10	10>
Al	10>	10>	10>	10>	10>	10>	10
Si	10>	10>	10>	10>	10>	10>	10>
Na	10>	10>	10>	10>	10>	10>	10>
Cl	100	80	90	80	110	40	100
粒度分布							
D90	1.10	0.83	0.81	0.97	1.50	1.60	1.62
D50	0.29	0.35	0.30	0.39	0.40	0.37	0.48
D10	0.13	0.15	0.19	0.14	0.25	0.23	0.30
SPAN	3.3	1.9	2.1	2.1	3.1	3.7	2.7

表2から明らかなように、実施例1～4はいずれも、酸素ガスおよび水素ガスは四塩化チタンに対して少量であり、水蒸気は四塩化チタンに対して過剰に供給し800～900°Cで反応させるため、得られた酸化チタン粉末のルチル化率は89.5%以上と高くかつ比表面積34m²/g以上と高かった。また、平均粒径は50nm以下と非常に微粒子にも拘わらず、狭い粒度分布を有しており、同時に溶媒中での分散性にも優れている。比較例1および3は、水素ガスの供給がなく、水蒸気量が過剰には供給されないため、比表面積は30m²/g未満となり、粒度分布も広いものであった。また、比較例2は、水蒸気の供給がないため、比表面積が小さく、また粒度分布も広いものであった。

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 より粒径が小さくかつ粒度分布が狭く、高比表面積であり、かつルチル化率の高い酸化チタン粉末を提供すること。

【解決手段】 ルチル化率が80%以上であって、BET比表面積が $30\text{ m}^2/\text{g}$ 以上である酸化チタン粉末。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2003-343189
受付番号	50301630853
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0094
作成日	平成15年10月 2日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成15年10月 1日
-------	-------------

特願 2003-343189

出願人履歴情報

識別番号 [390007227]

1. 変更年月日 1994年 7月 5日

[変更理由] 住所変更

住 所 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目3番5号
氏 名 東邦チタニウム株式会社